



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

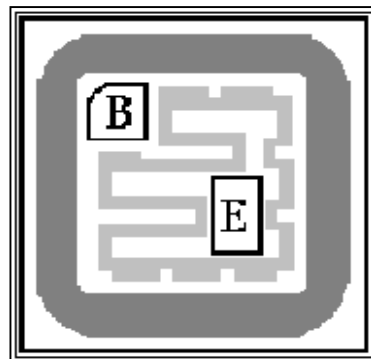
HE13001

对应国外型号
KSE13001

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：D083AG-00-XXX
 芯片厚度：240 ± 20μm
 管芯尺寸：830 × 830μm²
 焊位尺寸：B 极 140×144μm，E 极 180×140 μm
 电极金属：铝
 背面金属：金
 封装形式：TO-92

芯片图



极限值 (T_a=25)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温..... 150
 P_C——集电极耗散功率..... 900mW
 V_{CBO}——集电极—基极电压..... 600V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压..... 400V
 V_{EBO}——发射极—基极电压..... 9V
 I_C——集电极电流 (DC) 0.25A

电参数 (T_a=25)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	I _C =10mA, I _B =0
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	600			V	I _C =1mA, I _E =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	9			V	I _E =1mA, I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			100	μA	V _{CB} =500V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			100	μA	V _{EB} =9V, I _C =0
H _{FE}	直流电流增益	8		70		V _{CE} =10V, I _C =20mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和压降			0.6	V	I _C =100mA, I _B =20mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和压降			1.2	V	I _C =100mA, I _B =20mA
f _T	特征频率	8			MHZ	V _{CE} =10V, I _C =20mA